Группа

Лабораторная работа № 3

Вольтамперные характеристики биполярных транзисторов

Подготовка к работе

2, 3. Схемы для получения входных и выходных характеристик транзистора и методики определения его h-параметров.

методики определения его и параметров.	
Схема для получения входных характеристик	Схема для получения выходных характеристик
$U_{\kappa \mathfrak{I}} = $ (значения)	$I_6 =$ (значения)
Определение h_{119} (картинка)	Определение h_{219} (картинка)
Расчет h ₁₁₃ (формула)	Расчет h _{21э} (формула)

4. Формулы для расчета рабочего режима транзистора <u>по измеренным</u> <u>потенциалам</u> на выводах транзистора ϕ_3 , ϕ_k и ϕ_6 .

$$U_{\text{\tiny K} \ni \text{\tiny A}} =$$

$$U$$
бэ A $=$

 $I_{\rm KA} =$

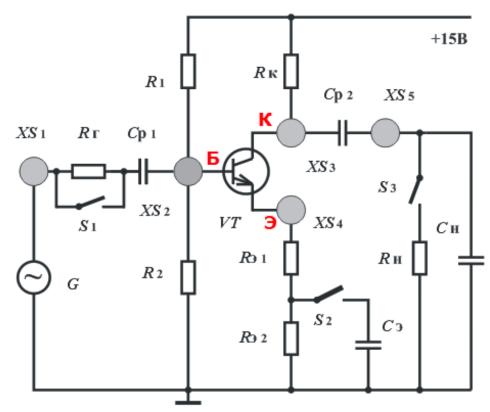


Рис. 2. Схема усилительного каскада с общим эмиттером

$$R_1$$
=10 кОм, R_2 =2.4 кОм, R_{κ} =390 Ом, $R_{\mathfrak{I}}$ =51 Ом, $R_{\mathfrak{I}}$ =51 Ом, $R_{\mathfrak{I}}$ =1 кОм, $R_{\mathfrak{I}}$ =10 кОм, $R_{\mathfrak{I}}$ =10

5. Аналитический расчет рабочего режима транзистора в схеме с ОЭ при β =120. <u>Уравнения</u>

$$I_{6A}=$$
 MKA, $I_{KA}=$ MA, $U_{K3A}=$ B.

Полученные значения внести в таблицу 2 протокола рабочего задания.